

s 2023 0010

Изобретение относится к технологии получения полупроводников и может быть использовано для изготовления оптоэлектронных приборов.

Способ получения тонких эпитаксиальных слоев TiO_2 включает обезжиривание стеклянной подложки в толуоле, ее сушку в парах изопропилового спирта и помещение этой в реактор химического осаждения из паровой фазы, который продувают аргоном в течение 20 мин при скорости потока $100 \text{ см}^3/\text{мин}$, после чего повышают температуру подложки до 400°C . Способ еще включает образование паров изопропоксида титана барботированием при температуре 90°C . Осаждение эпитаксиальных слоев TiO_2 осуществляют путем отдельной подачи в реактор паров изопропоксида титана, переносимые потоком аргона при скорости $40 \text{ см}^3/\text{мин}$, и потока кислорода при скорости $40 \text{ см}^3/\text{мин}$, в течение 30 мин.

П. формулы: 1